

Фамилия, имя, отчество	Коновалов Михаил Павлович
Должность, ученая степень, ученое звание	Доцент, к.т.н.
Электронная почта	konovalov.mp@misis.ru
Рабочий телефон	+7 499 237-21-29
Область научных интересов	физика полупроводников, физика и технология силовых полупроводниковых приборов, исследование радиационных воздействий на изделия электронной техники
Трудовая деятельность	2002-2004 гг. - инженер кафедры ППЭиФПП 2004-2007 гг. - ассистент кафедры ППЭиФПП 2007 - по н/в - доцент кафедры ППЭиФПП НИТУ МИСиС
Образование	Высшее, МИСиС 2001
Основные результаты деятельности	Выполнял обязанности куратора ИНМиН по очно-заочной форме обучения, являлся координатором образовательного проекта по целевому обучению коммерческих студентов МИСиС-Мосэнерго, принимал активное участие в образовательном Проекте подготовки кадров для Республики Узбекистан
Значимые проекты, гранты	
Значимые публикации	<p>Murashev V.N., Konovalov M.P., Legotin S.A., Didenko S.I., Rabinovich O.I., Krasnov A.A., Kuzmina K.A. Investigation of the irradiation influence with high-energy electrons on the electrical parameters of the IGBT-transistors. Journal of Nano-and Electronic Physics Vol. 7 No 1, 01011 (3pp) (2015).</p> <p>Краснов А.А., Максимов А.Н., Крымко М.М., Леготин С.А., Корнеев С.В., Коновалов М.П., Мурашев В.Н. Высоковольтный IGBT транзистор на основе trench структур. Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2015. № 2-3.</p> <p>Sleptsov E.V., Chernykh A.V., Chernykh S.V., Dorofeev A.A., Gladysheva N.B., Kondakov M.N., Sleptsova A.A., Konovalov M.P., Panichkin A.V., Didenko S.I. Investigation of the thermal annealing effect on electrical properties of Ni/Au, Ni/Mo/Au and Mo/Au Schottky barriers on AlGa_N/Ga_N heterostructures. Journal of Physics: Conference Series (Apr 2017).</p> <p>Chernykh S.V., Chernykh A.V., Baryshnikov F. M., Burtebayev N., Britvich G.I., Chubenko A.P., Keritnkulov Zh., Zholdybayev T., Nassurlla M., Konovalov M.P. Measurement and simulation of the response to fast neutrons of VPE GaAs detectors with polyethylene converter. IEEE Nuclear Science Symposium Medical Imaging Conference and Room- Temperature Semiconductor Detector Workshop (Oct 2017).</p> <p>Chernykh S.V., Chernykh A.V., Chubenko A.P., Pavlyuchenko L.N., Sveshnikov Yu. N., Glybin Yu. N., Konovalov M.P., Panichkin A.V., Didenko S.I. Detectors on the Basis of High- Purity Epitaxial GaAs Layers for Spectrometry of X and Gamma Rays. Instruments and experimental techniques 61(5) (Sep 2018)</p> <p>Shchemerov I.V., Legotin S.A., Lagov P.B., Konovalov M.P., Kirilov V.N. Radiation effect on the polymer-based capacitive relative humidity sensors. Nuclear Engineering and Technology, 2022, 54(8), pp. 2871-2876 DOI 10.1016/j.net.2022.02.027</p>
Значимые патенты	Патент № 2585880 от 10.06.2016 -ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА СИЛОВОГО БИПОЛЯРНО-ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
Научное руководство /Преподавание	Читаемые дисциплины "Физика конденсированного состояния", "Силовые полупроводниковые

	приборы"
--	----------

	Руководство НИР и выпускными работами бакалавров и магистров
--	--